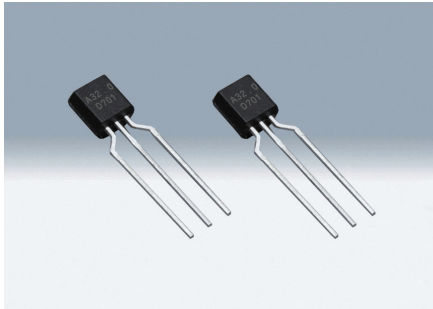


晶体振荡器

DLO555MBA



■ 优点

- TO92形状的小型晶体振荡器
- 内置旁路电容,可提高抗噪声能力
- 不使用PLL、倍频电路、采用直接输出振荡频率的电路结构(分频电路根据频率使用)
- 高速振荡启动(启动时间:1ms)
- CMOS输出

■ 用途

- 娱乐产品设备
- 工业设备

■ 型号含义

D L O 5 5 5 M B A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① D: 代表公司名(大真空)
- ② L: 代表引线类型产品
- ③ O: 代表SPXO
- ④、⑤ 5: 代表外形尺寸
- ⑥ 5: 代表端子数为3
- ⑦ M: 代表模具类型产品
- ⑧ B: Vcc:代表5V、CMOS输出
- ⑨ A: 耐冲击、电场的改良品



■ 最大额定

项目	符号	规格	单位
电源电压	V _{cc}	-0.5~+6.0	V
输出端子电压	V _{OUT}	-0.5~V _{cc} +0.5	V
输出端子电流	I _{OUT}	10	mA
保存温度范围	T _{str}	-40~+105	°C

■ 一般运行条件

项目	符号	min.	typ.	max.	单位
电源电压	V _{cc}	3.0	5.0	5.5	V
输出负载	L _{CMOS}	-	-	15	pF
				30	
运行温度范围	T _{opr}	-10	-	+85	°C

■ 一般规格

项目	符号	规格			单位	条件
		min.	typ.	max.		
输出频率范围	f _o	1.5	-	54	MHz	L _{CMOS} : 30pF
周波数許容偏差	-	-100	-	+100	×10 ⁻⁶	T _{opr} =-10~+85°C V _{cc} =+3.0~+5.5V
		-50		+50		
长期老化	-	-	-	±5	×10 ⁻⁶ /年	
消耗电流	I _{cc}	-	-	8	mA	No load
波形对称	SYM	45	-	55	%	50% V _{cc} level
0 电平电压	V _{OL}	-	-	V _{cc} ×0.1	V	
1 电平电压	V _{OH}	V _{cc} ×0.9	-	-	V	
上升时间	tr,tf	-	-	7.5	ns	L _{CMOS} : 30pF 20~80% V _{cc} level
下降时间						
振荡启动时间	T _{start}	-	-	1	ms	V _{cc} 达到默认值的90%以后经过的时间
相位噪声	-	-	-139	-	dBc/Hz	Offset 1kHz
		-	-156	-		Offset 100kHz
周期抖动(1)	t _{RMS}	-	2.4	-	ps	σ
	tp-p	-	20	-		Peak to peak
总抖动(1)	t _{TL}	-	34	-	ps	t _{DJ} +n×t _{RJ} n=14.1(BER=1×10 ⁻¹²) (2)
相位抖动(3)	tpj	-	-	1		10MHz≤f _o <40MHz f _o offset 12kHz~5MHz
					40MHz≤f _o ≤54MHz f _o offset 12kHz~20MHz	
内置的旁路电容值	C _{bp}	-	0.1	-	μF	V _{cc} -GND间的电容

(1) 通过WAVECREST DTS-2075测量

(2) t_{DJ}:Deterministic jitter t_{RJ}:Random jitter

(3) 通过Keysight Technologies E5052B测量

※ 无需防湿包装管理 Moisture Sensitivity Level:LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

■ 外形尺寸·标记·外观说明

■ 外形尺寸

1:Output
2:GND
3:Vcc

单位:mm
公差:0.5mm

■ 标记

- ① 型号:A
- ② 公称频率:包括小数点在内在显示为4位通过阿拉伯数字和字母来表示
- ③ 公司标志(D)
- ④ 批号:年1位 周2位(YWW)
例 2017/1/1⇒701

■ 外观说明

标记:激光刻字
模具部:黑色(表面状态:磨砂)
引线部:银色

喷印部分使用从1到9的数字以及大小写字母刻印1位或2位的生产信息。这个字符表示的是生产信息,与型号、频率等标记无关。